



2025 年 10 月 17 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ キ サ イ ド
代 表 者 名 代表取締役社長 (COO 兼 CFO) 山 本 正 幸
(コード番号 : 6521 東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員 (CSO) 企画本部長 竹 内 健 吾
(TEL. 0551-26-0022)

2026 年 2 月期 第 2 四半期 決算説明会の質疑応答（要旨）について

当社は、昨日決算説明会（アナリスト・機関投資家向け）を開催いたしました。ご出席の皆様からいただいた主なご質問を以下にまとめております。なお、理解促進のため、一部加筆修正を行い要旨として記載をしております。

- Q. この度の上半期赤字決算という結果に、大変残念に思っております。通期の業績予想に変更はないとのことですが、上半期の実績を踏まえると、その見通しに対する確信を持つことが難しい状況です。通期業績予想に変更がないとされる根拠について、詳細なご説明をお願いします。
- A. まず、上半期における連結業績の下振れの主要因である Raicol 社における、下半期の回復見込みについてご説明いたします。主に 4 点ございます。
- ① 研究開発補助金の受領時期変更：上半期計画分の研究開発補助金 7,000 万円の下半期受領と下半期予定額の計画通りの受領により、上半期から下半期へ 1 億 5,000 万円程度の損益改善が見込まれます。
 - ② 貸倒引当金の計上：上半期に計上した貸倒引当金は、下半期には計上を見込んでおりません。
 - ③ 製造コストの軽減：製造コストは、下半期は 5,000 万円程度の軽減が見込まれます。
 - ④ 売上高の回復：3Q を中心に売上高の回復があり、営業損益面で少なくとも 5,000 万円は改善見込みです。

以上、下半期の営業損益は、上半期対比 2 億 8,000 万円程度改善し、収支均衡を見込んでおります。先日、イスラエル政府とハマスとの間で停戦の第 1 段階が合意されましたが、依然としてイスラエル情勢は不安定のため、慎重な見方をしております。

一方、オキサイド単体では、半導体事業および新領域事業で複数の予算外案件を見込んでおります。これにより上半期の下振れ分をリカバリーできるものと判断し、全社で取り組んでおります。

上半期連結営業損益内訳

OXIDE

■ 上半期連結営業損益の内訳は、オキサイド単体で予想を上回りましたが、Raicol社で2億2,800万円下回りました。

〔Raicol社営業損益 予想比の内訳〕

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. 紛争の影響による製造コスト増 | : ▲約70百万円 |
| 2. 紛争の影響による研究開発補助金の下半期ずれ込み | : ▲約65百万円 |
| 3. 不買運動拡大による売上減少とイラン衝突による期ずれ | : ▲約50百万円 |
| 4. 過年度の売掛金回収難航による引当金計上 | : ▲約40百万円 |

(単位:百万円)

項目	26年2月期 1Q			26年2月期 2Q			26年2月期 上半期		
	予想	実績	予想比	予想	実績	予想比	予想	実績	予想比
連結営業損益※1	▲ 215	▲ 72	+ 142	265	▲ 117	▲ 382	50	▲ 189	▲ 240
OXIDE単体	▲ 66	168	+ 235	344	143	▲ 200	277	312	+ 35
Raicol	▲ 47	▲ 111	▲ 63	▲ 9	▲ 174	▲ 164	▲ 57	▲ 285	▲ 228
OPC※2	▲ 100	▲ 126	▲ 25	▲ 69	▲ 69	▲ 0	▲ 169	▲ 196	▲ 26

※1 連結と各内訳数字合計の差異は、連結調整によるものです。

Copyright: 2025 OXIDE Corporation. All Rights Reserved.

※2 OPC:当社100%子会社で、SiC事業に取り組むオキサイドパワークリスタル社の略称です。

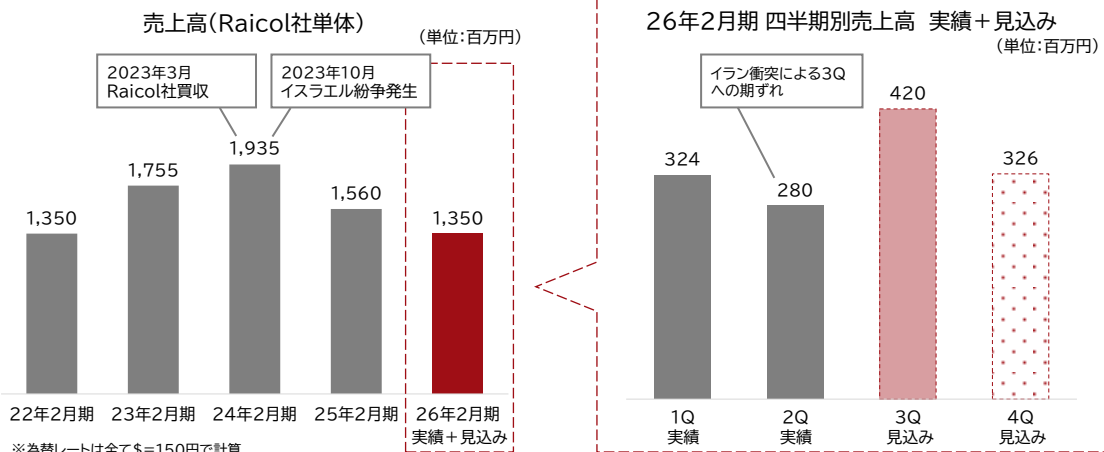
5

Raicol社単体 売上高

OXIDE

■ Raicol社の売上高は、2023年10月に発生した紛争を勘案して予想しておりましたが、2025年6月に発生したイラン衝突の影響を受け、第3四半期への期ずれが発生いたしました。

■ 依然としてイスラエル情勢は不安定なため、売上水準の回復については慎重な見方をしております。



Copyright: 2025 OXIDE Corporation. All Rights Reserved.

6

- Q. 青色をした p 型 SiC ウェハについて、その技術的な優位性や特徴を具体的にご説明ください。
また、現在の開発フェーズと、量産目標時期を教えてください。
- A. 次世代の超高耐压パワー半導体、例えば HVDC（高電圧直流送電システム）等に用いられる IGBT の性能を飛躍的に向上させる上で、「高品質な p 型 SiC（炭化ケイ素）ウェハ」は不可欠な部材です。しかしながら、従来の昇華法では、ウェハの大口径化や、電気特性を決定づける元素を均一に添加することが極めて困難であり、長年にわたる技術的課題とされておりました。
- 我々は、独自の溶液成長法を用いることでこの課題を解決し、国内で初めて実用化サイズの高品質 p 型 SiC ウェハの試作に成功いたしました。ご質問の「青色」は、p 型の電気伝導性を付与する添加物が、結晶全体にわたり均一かつ高濃度で取り込まれていることを視覚的に示すものです。これは、昇華法では達成が困難であった高品質・高均一化を実現したことの現れです。
- 現在、本ウェハはサンプル出荷の段階にあります。今後は、デバイスメーカー各社における評価や応用開発の進捗を踏まえ、2029 年頃の量産開始を目指してまいります。本製品は、次世代電力インフラの性能向上に不可欠な技術であり、エネルギー効率の向上に大きく貢献するものと期待しております。

02.事業別業績

新領域 | SiC事業の進捗

OXIDE

- オキサイドパワークリスタル社が幹事を務めるコンソーシアムは、革新的な溶液成長法とAIデジタルツインを駆使し、6インチp型SiCウェハ試作に成功しました。※1
- 世界最大級のSiC国際会議「ICSCRM2025」にて成果を発表し、国際的に高く評価されました。
- 本成果により、直流送電・データセンター電源など、次世代社会インフラを支える材料技術の扉を開きました。

p型SiCウェハ開発で6500V超 IGBT実現へ

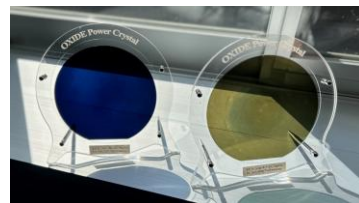
- 6500V超の超高耐压IGBTには高品質なp型SiCウェハが不可欠
- 従来の昇華法では大口径化やドーピング制御に限界がありp型SiCの製作は困難
- 独自の溶液成長法によりp型SiCウェハの試作に成功、直流送電等への応用が期待される超高耐压SiC-IGBTの開発の進展が期待される



欧州で計画されている直流送電網※2

SiCウェハの色とドーパントの関係

- SiCはドーパントによる光吸収特性の違いで色が変わり、n型ウェハは琥珀色、p型ウェハは青色を示す
- 青色を示すp型SiCウェハ試作に成功



6インチp型ウェハ(左) 6インチn型ウェハ(右)

※1 本成果は、NEDOグリーンイノベーション基金事業「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクトの一環として実施されたものです。
メンバーは株式会社オキサイドパワークリスタル、マイボックス株式会社、株式会社UJ-Crystal、アイクリスタル株式会社、産業技術総合研究所、名古屋大学です。

※2 国際環境経済研究所Webサイト https://ieei.or.jp/2023/05/santo_20230518/

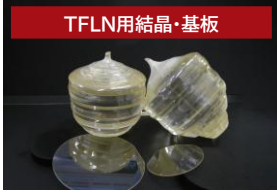
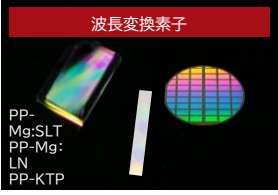
- Q. TFLN（薄膜ニオブ酸リチウム）技術は、「光量子コンピュータ産業化に不可欠」とのことですが、その重要性についてもう少し詳しく教えてください。例えば、光量子コンピュータの実現において、TFLN 技術が担う具体的な役割は何ですか？
- A. 光量子コンピュータの心臓部ともいえる光信号処理回路の実現に必要不可欠な部品材料です。現状の光量子コンピュータでは、従来の光ファイバや導波路部品を組み合わせて大型の光学定盤上に光信号処理回路を構成しています。当社が取り組む TFLN を用いることでより高機能な光回路を1枚の基板上に集積することが可能になります。具体的には、量子もつれ光の発生や光増幅、光変調機能をリソグラフィプロセスで作製できるようになります。また TFLN は、Si（シリコン）や InP（インジウムリン）の半導体材料に比べ高速、低損失などの特長を持ちます。このように、次世代の光量子コンピュータに不可欠な材料と期待されます。現時点で TFLN を製造できる企業は世界的にも限られており、経済安全保障の観点からも、オキサイドがこのテーマに取り組むことは、社会的な意義があると考えています。

02.事業別業績

新領域 | 量子分野の取組み

OXIDE

- NEDOが公募した「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」において、「光量子コンピュータ産業化に向けた TFLN（薄膜ニオブ酸リチウム）※1 光技術の研究開発」に当社が採択されました。
- TFLNは従来の光学素子の性能を大幅に向上させる光学材料として注目されており、光量子コンピュータ開発の鍵となる材料です。
- 当社のコア技術である光学単結晶の育成技術を活用し、量子分野において最上流に位置する高品質なTFLN用の基板材料技術確立を目指してまいります。

本事業の対象	現在の製品ポートフォリオ		
TFLN用結晶・基板 	波長変換素子 PP-Mg:SLT PP-Mg:LN PP-KTP 	量子もつれ光子対光源モジュール EPS-SNα series Sagnac type module 	量子コンピューティング用レーザー 
川上(応用範囲が広い)	量子分野における応用の汎用性		川下(特定分野で高い付加価値)

※1 ニオブ酸リチウムという結晶をナノレベルまで薄く加工した新素材で、光信号を非常に効率よく制御できる特性を持ちます。
従来材料よりも低い電力で、より高速かつ小型の光通信デバイスを作ることができ、光通信や光量子コンピュータの中核技術として注目を集めています。

Copyright: 2025 OXIDE Corporation. All Rights Reserved.

12

- Q. 半導体事業およびヘルスケア事業の四半期ごとの売上高トレンドについて伺います。半導体事業は、下半期の売上高が上半期を上回る見込みでしょうか。また、ヘルスケア事業について、第2四半期の増収要因と第3四半期以降の見通しをご説明ください。
- A. 半導体事業につきましては、メンテナンス需要の増加等が見込まれることから、下半期の売上高は上半期を上回る見通しです。
- ヘルスケア事業につきましては、第2四半期の増収は、主に高性能 PET トップメーカー向け出荷が本格化したことに加え、前期第4四半期から期ずれが寄与しました。下半期の売上高は、この期ずれ影響がなくなるため、上半期を若干下回る見通しです。

- Q. 連結の通期業績予想は据え置きと理解しております。オキサイド単体で取り組んでいる予算外案件の詳細と、Raicol 社の通期見通しについてご説明ください。
- A. オキサイド単体では、半導体事業および新領域事業で新規案件の開拓に取り組んでまいりました。特に新領域事業ではデータセンター向けの新規案件を獲得見込みです。Raicol 社につきましては、売上高は通期で当初予想と同水準を見込んでおりますが、営業損益は予想を下回る見通しです。
- Q. 量子分野における TFLN の量産予定時期をお教えください。
- A. TFLN の量産時期につきましては、現時点で具体的な時期を明言することは難しい状況です。研究開発用途の小口径基板は既に市場がありますが、光量子コンピュータ等の社会実装に不可欠な大口径基板の量産技術は、世界的に見ても開発途上にあります。今後 2〜3 年で大口径基板の開発や評価が加速し、社会実装が進むと想定されます。当社としましては、本 TFLN の取り組みを通じて、重要な技術分野の研究開発加速に貢献してまいります。
- Q. TFLN の市場機会について、光量子コンピュータ以外に光通信用変調器としての可能性はありますか。また、現在のシリコンフォトニクス主流は InP (インジウムリン) と理解していますが、将来的に TFLN が中心となる可能性はあるのでしょうか。加えて、本テーマのサプライチェーンにおける川下企業との提携の可能性についてもお聞かせください。
- A. 光量子コンピュータへの応用に先立ち、短期的には光通信用変調器が主要な市場機会になると考えております。現状では小型化が可能な InP (インジウムリン) や Si (シリコン) が先行しておりますが、高速性に限界があります。TFLN は高速性に優れ、薄膜化することで小型化が可能になるため最先端の通信システムは TFLN に置き換わるものと期待されています。したがって、ご指摘通り、まずは光通信分野での変調器、次いで市場規模の大きな光量子コンピュータという順で事業機会が拡大していくものと考えております。
- 当社が参画する NEDO プロジェクトには、素材メーカーからデバイス・装置メーカーまで、サプライチェーンの川上から川下に至る多くの企業が参画しております。当社はこれらの企業との連携を積極的に深め、事業化を推進してまいります。